

عنوان مقاله:

رفتار لایه های نقص نانویی در بلورهای فوتونی

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

بایرام کاظم پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

خلاصه مقاله:

در این مقاله اثر لایه نقص در بلور فوتونی یک بعدی با بهره گیری از روش ماتریس انتقال مورد مطالعه قرار گرفته شده است نشان داده شده است که مدهای نقص جایگزیده در این لایه جزئی متمرکز بوده است در این کار وابستگی موقعیت این مدها به پارامترهای فیزیکی لایه نقص نظیر ثابت دی الکترونیک گزارش شده است.

کلمات کلیدی:

مدنقص، ماتریس انتقال، مواد راستگرد، مواد چپگرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/103660>

